ผลและการอภิปรายผล

บทที่ 4 เป็นผลการทคลองและวิเคราะห์ผลการทคลองที่ได้จากการตรวจสอบ สมบัติทางกายภาพ และสมบัติทางไฟฟ้าของคอมโพสิท BaTiO₃/PVDF ที่ได้จากการเตรียมใน ห้องปฏิบัติการ

4.1 การตรวจสอบสมบัติทางกายภาพของคอมโพสิท BaTiO₃/PVDF

4.1.1 ลักษณะของคอมโพสิท BaTiO₃/ PVDF ที่เตรียมในห้องปฏิบัติการ

การเตรียมคอมโพสิท BaTiO₃/PVDF โดยใช้สารละลาย PVDF : NMP ใน อัตราส่วน 10:90 และใช้ BaTiO₃ : PVDF ในอัตราส่วน 15 : 85 และ 30 : 70 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก ตามลำดับ เนื่องจากสัดส่วนของเซรามิกที่มีค่าต่ำกว่า 50 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักจะถือว่าน้อยและ สามารถนำแบบจำลองเพาเออร์มาใช้ได้ ขึ้นรูปด้วยวิธีขึ้นรูปแบบเทปทำให้สารตัวอย่างเป็นแผ่นที่มี ลักษณะเป็นสีขาวขุ่น ความหนาไม่สม่ำเสมอตลอดทั้งแผ่นโดยมีความหนาเฉลี่ยอยู่ในช่วง (28 ± 3)µm

4.1.2 โครงสร้างจุลภาคของคอมโพสิท BaTiO₃/PVDF ที่เตรียมในห้องปฏิบัติการ

ผลจากภาพถ่าย SEM ของคอมโพสิท BaTiO₃/PVDF ทำให้สามารถทราบถึง ลักษณะของการกระจายตัวของของเซรามิกในเมตริกซ์พอลิเมอร์ได้ ซึ่งสามารถแสดงดัง ภาพประกอบที่ 4.1 และภาพประกอบที่ 4.2



ภาพประกอบที่ 4.1 ภาพถ่าย SEM ของคอมโพสิท BaTiO₃/PVDF สำหรับ φ = 0.15 กำลังขยาย 2,500 เท่า



ภาพประกอบที่ 4.2 ภาพถ่าย SEM ของคอมโพสิท BaTiO₃/PVDF สำหรับ φ = 0.3 กำลังขยาย 2,500 เท่า

จากภาพของคอมโพสิท BaTiO₃/PVDF ที่ถ่ายด้วยกำลังขยาย 2,500 เท่า ที่เตรียม ด้วย วิธีขึ้นรูปแบบเทป และผ่านกระบวนการอบอ่อนที่อุณหภูมิ 120 °C เป็นเวลา 6 ชั่วโมง จากการ วิเคราะห์การกระจายเม็ดเซรามิกมีการเรียงติดกันแบบ 0-3 เป็นส่วนใหญ่ อีกแบบหนึ่งคือแบบ 3-3 โดยจุดสีขาวขุ่นที่เห็นในรูป คือ อนุภาคของแบเรียมไททาเนตที่กระจายตัวในพอลิเมอร์ PVDF

4.2 การตรวจสอบสมบัติทางไฟฟ้าของคอมโพสิท BaTiO₃/PVDF

4.2.1 สมบัติไดอิเล็กตริก

สำหรับค่าคงที่ใดอิเล็กตริกของคอมโพสิท BaTiO₃/PVDF ที่เตรียมใน ห้องปฏิบัติการ โดยวัดค่าความจุไฟฟ้าที่ความถี่ต่าง ๆ นำค่าที่ได้ไปคำนวณค่าคงที่ใดอิเล็กตริก โดย ใช้สมการที่ (2.22) ส่วนค่าการสูญเสียใดอิเล็กตริกที่ความถี่ต่าง ๆ สามารถอ่านค่าได้โดยตรงจาก เครื่อง LCR meter ซึ่งความสัมพันธ์ของค่าที่ใดอิเล็กตริกและ ค่าสูญเสียใดอิเล็กตริกกับความถี่ ต่างๆ แสดงดังภาพประกอบที่ 4.3, 4.4 และ 4.5



ภาพประกอบที่ 4.3 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าคงที่ใดอิเล็กตริกกับความถี่ของคอมโพสิท BaTiO₃/PVDF สำหรับ φ = 0.30 ที่เตรียมในห้องปฏิบัติการ โดยที่ A คือ โพลิง ทั้งสองเฟสในทิศเดียวกัน B คือ โพลิงในทิศตรงข้ามกันและ C คือ ไม่มีการ โพลิง



ภาพประกอบที่ 4.4 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าคงที่ใดอิเล็กตริกกับความถี่ของคอมโพสิท BaTiO₃/PVDF สำหรับ $\phi = 0.15$ ที่เตรียมในห้องปฏิบัติการโดยที่ A คือ โพลิง ทั้งสองเฟสในทิศเดียวกัน B คือ โพลิงในทิศตรงข้ามกันและ C คือ ไม่มีการ โพลิง



ภาพประกอบที่ 4.5 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าสูญเสียใดอิเล็กตริกกับความถึ่ของคอมโพสิท BaTiO₃/PVDF โดยที่ A และ C โพลิงทั้งสองเฟสในทิศตรงข้ามกัน B และ D คือ โพลิงในทิศเดียวกัน

จากภาพประกอบที่ 4.3, 4.4 และ 4.5 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างค่าคงที่ใดอิ เล็กตริกและค่าการสูญเสียใดอิเล็กริกกับความถี่ในช่วงต่างๆ ป้อนให้แก่สาร พบว่าพฤติกรรมมี ถักษณะที่คล้ายคลึงกัน คือในช่วงความถี่ต่ำค่าคงที่ใดอิเล็กตริกและค่าการสูญเสียใดอิเล็กตริกมีค่า สูงและลดลงค่อนข้างคงที่ในช่วงที่ความถี่สูง เนื่องจากช่วงความถี่ต่ำเป็นความถี่ที่โมเมนต์ขั้วคู่ทาง ใฟฟ้าสุทธิมีค่ามากในวัสดุคอมโพสิทตอบสนองต่อสนามไฟฟ้าได้ดี จึงทำให้ค่าคงที่ใดอิเล็กมีค่า มากขึ้นเช่นกัน ในขณะเดียวกันมีพลังงานไฟฟ้าส่วนหนึ่งสูญเสียไปในเนื้อสารด้วย ซึ่งพฤติกรรมนี้มี ลักษณะคล้ายวัสดุพรุน (porous material) คือ มีการสูญเสียพลังงานไปเป็นรูปอื่นได้ง่ายขึ้นเมื่อ ความถี่สูงขึ้น

เมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการ โพลิงในเฟสของแบเรียมไททา เนตและเฟสของพอลิเมอร์ PVDF กับค่าคงที่ไดอิเล็กตริกและค่าการสูญเสียไดอิเล็กริก พบว่าเมื่อมี การ โพลิงทั้งสองเฟสในทิศเดียวกัน คอมโพสิท BaTiO₃/PVDF จะมีค่าคงที่ไดอิเล็กตริกที่สูงที่สุด และในขณะเดียวกันมีค่าการสูญเสียไดอิเล็กที่ต่ำที่สุดในช่วงความถี่ที่ใช้ทดลอง เนื่องจากเมื่อมีการ โพลิงทั้ง 2 เฟสแล้ว จะทำให้เกิดการเสริมกันของโมเมนต์ขั้วคู่ทางไฟฟ้าของแต่ละเฟสส่งผลให้ โมเมนต์ขั้วคู่ทางไฟฟ้าสุทธิมีค่ามากในวัสดุ นอกจากนี้ยังพบว่าค่าคงที่ไดอิเล็กตริกและค่าการ สูญเสียไดอิเล็กริกจะแปรผันตรงตามสัดส่วนของเซรามิกที่ใช้

สำหรับแบบที่ไม่มีการ โพลิง พอลิเมอร์ PVDF จะไม่เกิดการตกผลึกและเปลี่ยน เฟสเบตา ทำให้ไม่มีโมเมนต์ขั้วกู่สุทธิและไม่มีสภาพกวามเป็นขั้ว จึงไม่แสดงสมบัติไดอิเล็กตริกที่ดี

4.2.2 สมบัติไพโรอิเล็กตริก

จากการศึกษาค่าคงที่ไพโรอิเล็กตริกของคอมโพสิท BaTiO₃/PVDF โดยหาได้จาก สมการที่ (2.16) หรือความชันของกราฟซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ และโพลาไรเซชัน ดังภาพประกอบที่ 4.6, 4.7, 4.8 และ 4.9 ตามลำดับดังนี้



ภาพประกอบที่ 4.6 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าโพลาไรเซชันกับอุณหภูมิของคอมโพสิท BaTiO₃/PVDF ที่ φ = 0.15 และโพลิงทั้งสองเฟสในทิศตรงข้ามกัน ค่าความชัน ของกราฟ เท่ากับ - 19 μC/m²°C



ภาพประกอบที่ 4.7 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าโพลาไรเซชันกับอุณหภูมิของคอมโพสิท BaTiO₃/PVDF ที่ φ = 0.15 และโพลิงทั้งสองเฟสในทิศเดียวกัน ค่าความชัน ของกราฟ เท่ากับ - 25 μC/m²°C



ภาพประกอบที่ 4.8 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าโพลาไรเซชันกับอุณหภูมิของคอมโพสิท BaTiO₃/PVDF ที่ φ = 0.30 และโพลิงทั้งสองเฟสในทิศตรงข้ามกัน ค่าความ ชันของกราฟ เท่ากับ - 24 μC/m^{2°}C



ภาพประกอบที่ 4.9 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าโพลาไรเซชันกับอุณหภูมิของคอมโพสิท BaTiO₃/PVDF ที่ φ = 0.30 และโพลิงทั้งสองเฟสในทิศเดียวกันค่าความชันของ กราฟ เท่ากับ - 41 μC/m^{2°}C

จากภาพประกอบที่ 4.6, 4.7, 4.8 และ 4.9 พิจารณาความสัมพันธ์ค่าคงที่ไพโรอิเล็ก ตริกที่วัดโดยวิธีของ Byer และ Roundy (Byer and Roundy, 1972) สามารถวัดค่าคงที่ไพโรอิเล็ก ตริกได้จากการวัดปริมาณการเปลี่ยนแปลงของประจุในขณะที่มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของสาร ตัวอย่างในอัตราคงที่ และหาค่าคงที่ไพโรอิเล็กตริก ได้จากค่าความชันของกราฟพบว่า ค่าคงที่ไพ โรอิเล็กตริกของคอมโพสิท BaTiO₃/PVDF ที่ φ = 0.15 และ φ = 0.30 และโพลิงทั้งสองเฟสในทิศ เดียวกัน เท่ากับ 25 และ 41 µC/m²°C ตามลำดับ และเมื่อโพลิงทั้งสองเฟสในทิศตรงข้ามกัน มีค่า เท่ากับ 19 และ 24 µC/m²°C ตามลำดับ ค่าคงที่ไพโรอิเล็กตริกที่ได้เป็นผลรวมที่ไม่ได้มาจากการ เปลี่ยนแปลงโพลาไรเซชันอะนเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิเพียงอย่างเดียว แต่มาจากการ เปลี่ยนแปลงขนาดเนื่องจากสมบัติไพอิโซอิเล็กตริกและการขยายตัวทางความร้อนของสารร่วมด้วย จะเห็นว่าค่าคงที่ไพโรอิเล็กตริกมีเครื่องหมายลบ (ค่าความชันของกราฟเป็นลบ) แสดงว่าการที่มี อุณหภูมิสูงขึ้นทำให้การจัดเรียงตัวของไดโพลไฟฟ้าในสารมีความไร้ระเบียบมากขึ้น

4.2.3 สมบัติไพอิโซอิเล็กตริก

ทำการปรับเทียบระบบอินเทอร์เฟอร์ โรมิเตอร์ โดยใช้สารตัวอย่าง PZT ทางการค้า ผ่านการทำขั้วไฟฟ้าและนำมายึดติดกับระบบอินเทอร์เฟอร์ โรมิเตอร์ ปรับทางเดินแสงเลเซอร์ที่ สะท้อนจากสารตัวอย่าง และแผ่นกระจกอ้างอิงให้รวมเป็นจุดเดียวกันเพื่อให้เกิดการแทรกสอดมาก ที่สุดที่สอดคล้องกับสมการที่ (2.27) แสดงดังภาพประกอบที่ 4.10 เปิดวงจรป้อนสัญญาณย้อนกลับ โดยไม่มีการสั่นของ PZT พบว่าสัญญาณที่เกิดจากกรสั่นของกระจกอ้างอิงมีลักษณะดัง ภาพประกอบที่ 4.11 ซึ่งทำให้ได้ก่า V_{p-p} จากนั้นป้อนสัญญาณให้กับสารตัวอย่างและวัดการกระจัด ผิวหน้า ภาพประกอบที่ 4.12 แสดงระยะการกระจัดต่อศักย์ไฟฟ้าที่ให้ จากกราฟความชันของกราฟ กือค่าคงที่พิโซอิเล็กตริกในแนวกวามหนาของสารตัวอย่าง



ภาพประกอบที่ 4.10 แสดงแสงเลเซอร์ที่สะท้อนจากสารตัวอย่าง และแผ่นกระจกอ้างอิงที่รวมเป็น จุดเดียวกันและเกิดการแทรกสอด



ภาพประกอบที่ 4.11 แสดงภาพบนจอออสซิลโลสโคป เป็นสัญญาณจากหัววัดแสงเมื่อมีการสั่น กระจกอ้างอิงเพียงอย่างเดียวในขณะที่วงจรป้อนสัญญาณย้อนกลับกำลัง ทำงาน ในภาพ V_{p-p} ขณะที่ถูกควบคุมด้วยวงจรป้อนสัญญาณย้อนกลับ แอม ปลิจูดของสัญญาณในภาพ คือ V_{p-p} มีก่า 0.3 V โดยประมาณ



ภาพประกอบที่ 4.12 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการกระจัดกับความต่างศักย์ไฟฟ้าของ PZT ทาง การค้าที่ความถี่ 4 kHz

ความชั้นของกราฟคือค่าคงที่ไพอิโซอิเล็กตริกของ PZT ทางการค้า พบว่า d₃₃ = 198 pm/V ในขณะที่ค่า d₃₃ ของ PZT จะอยู่ในช่วง 180 – 250 pm/V (Pan and Cross, 1989)

จากนั้นศึกษาค่าคงที่ไพอิโซอิเล็กตริกของของคอมโพสิท BaTiO₃/PVDF พบว่าที่ $\phi = 0.30$ เท่านั้นที่แสดงสมบัติไพอิโซอิเล็กตริก ส่วนที่ $\phi = 0.15$ ไม่แสดงสมบัติไพอิโซอิเล็กตริก อาจเป็นเพราะสารตัวอย่างมีความยืดหยุ่นสูงเพราะมีสัดส่วนของเพอลิเมอร์มากเกินไป แต่ยังไรก็ ตามอาจวัดค่าคงที่ไพอิโซอิเล็กตริกได้ ถ้าสารตัวอย่างมีการขึ้นรูปด้วยเครื่องฉาบแบบหมุน (spin - coater) และค่าคงที่ไพอิโซอิเล็กตริกหาได้จากสมการที่ (2.30) หรือความชันของกราฟซึ่ง แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการกระจัดเชิงผิวกับความต่างศักย์ดังภาพประกอบที่ 4.13 และ 4.14 ตามลำดับดังนี้



ภาพประกอบที่ 4.13 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างการกระจัดเชิงผิวกับความต่างศักย์ของคอมโพสิท BaTiO₃/PVDF ที่ ф = 0.30 และโพลิงทั้งสองเฟสในทิศเดียวกันที่ความถี่ 5 kHz ค่าความชันของกราฟคือค่าคงที่ไพอิโซอิเล็กตริกเท่ากับ 8.9 pm/V



ภาพประกอบที่ 4.14 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างการกระจัดเชิงผิวกับความต่างศักย์ของคอม โพสิท BaTiO₃/PVDF ที่ ϕ = 0.30 และ โพลิงทั้งสองเฟสในทิศตรงข้ามกันที่ความถี่ 5 kHz ค่าความชันของกราฟคือค่าคงที่ไพอิโซอิเล็กตริกเท่ากับ 11.6 pm/V

จากการศึกษาค่าคงที่ไพอิโซอิเล็กตริกของคอมโพสิท BaTiO₃/PVDF $\phi = 0.30$ ที่ ความถี่ 1-7 kHz พบว่าเมื่อสารตัวอย่างได้รับการโพลิงทั้งสองเฟสในทิศตรงข้ามกัน มีค่าค่าคงที่ไพอิ โซอิเล็กตริก (d₃₃) เฉลี่ยเท่ากับ (11.4 ± 0.1) pm/V ซึ่งจะแสดงสมบัติไพอิโซอิเล็กตริกได้ดีกว่าเมื่อ สารตัวอย่างได้รับการโพลิงทั้งสองเฟสในทิศเดียวกัน ที่มีค่าคงที่ไพอิโซอิเล็กตริก (d₃₃) เฉลี่ย เท่ากับ (8.7 ± 0.1) pm/V ดังภาพประกอบที่ 4.15

ในขณะเดียวกันเมื่อพิจารณาค่าคงที่ไพโรอิเล็กตริกจะพบว่าเมื่อสารตัวอย่างได้รับ การโพลิงทั้งสองเฟสในทิศตรงข้ามกัน จะมีค่าที่น้อยกว่าเมื่อสารตัวอย่างได้รับการโพลิงทั้งสองเฟส ในทิศเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของ Chan และคณะ (Chan *et. al*, 1999)



ภาพประกอบที่ 4.15 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าคงที่ไพอิโซอิเล็กตริก (d₃₃) กับ ความถี่ในช่วง 1-7 kHz ของฟิล์มคอมโพสิท BaTiO₃/PVDF φ = 0.30 ที่ได้รับการโพลิงทั้ง สองเฟสในทิศตรงข้ามกัน และได้รับการโพลิงเฉพาะทั้งสองเฟสในทิศ เดียวกัน

BaTiO ₃ /PVDF	φ = 0.15			φ = 0.30		
at 25 °C	А	В	С	А	В	С
$\varepsilon_r (1 \text{ kHz})$	0.80	9.75	8.77	0.80	11.48	9.77
$tan \delta$ (1 kHz)	0.43	0.20	0.30	0.48	0.21	0.31
p (μC/m ^{2°} C)	-	25	19	-	41	24
d_{33} (×10 ⁻¹² m/V)	-	*	*	-	8.7	11.6
c (J/kg °C)	866.2			3021.7		
	(2085.1)	-	-	(1847.5)	-	-
$\rho (\times 10^{3} \text{kg/m}^{3})$	2.52			3.21		
	(2.39)	-	-	(3.04)	-	-

ตารางที่ 4.1 แสดงการวิเคราะห์ผลเปรียบเทียบระหว่าง φ = 0.15 กับ φ = 0.30 และค่าที่คำนวณได้ ทางทฤษฎีอยู่ในวงเล็บ

* ไม่สามารถวัดได้

เมื่อ A ไม่มีการโพลิง

B โพลิงทั้งสองเฟสในทิศเดียวกัน

C โพถิ่งทั้งสองเฟสในทิศตรงข้ามกัน

จากตารางที่ 4.1 เมื่อพิจารณาปริมาณต่างที่ได้ คือ ค่าคงที่ไดอิเล็กตริก, ค่าการ สูญเสียไดอิเล็กริก และค่าคงที่ไพโรอิเล็กตริก พบว่า จะขึ้นกับปัจจัย 2 ปัจจัย ได้แก่ สัดส่วนของเซรา มิกที่ใช้ และกระบวนการโพลิงในแต่ละเฟส ส่วนค่าคงที่ไพอิโซอิเล็กตริก ไม่สามารถวิเคราะห์ได้ ว่าขึ้นกับสัดส่วนของเซรามิกที่ใช้ เนื่องจากสารตัวอย่างไม่มีการตอบสนองทางไพอิโซอิเล็กตริกที่ \$\phi\$ เท่ากับ 0.15 ส่วนค่าความจุความร้อนที่ได้จากการทดลองและคำนวณทางทฤษฎีนั้นมีความคลาด เคลื่อนที่สูงมาก อาจเป็นผลมาจากการขยายตัวของเฟสพอลิเมอร์ในระหว่างการวิเคราะห์ผล แต่ อย่างไรก็ตาม เมื่อวิเคราะห์ค่าความหนาแน่นที่ได้จากการทดลองและคำนวณทางทฤษฎีนั้นมี มี ความคลาดเคลื่อนประมาณ 5 เปอร์เซ็น ซึ่งสอดคล้องตามทฤษฎีของ 0 – 3 คอมโพสิท จากก่าต่างๆ ที่ได้ จะเห็นได้ว่า สามาถนำคอมโพสิทนี้ มาประยุกต์ใช้ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ด้องการสิ่งประดิษฐ์ น้ำหนักเบา ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวคล้อม (ดูภาคผนวก ฉ)